07

Возбуждение лучевых колебаний в квазиоптических диэлектрических резонаторах с модами шепчущей галереи

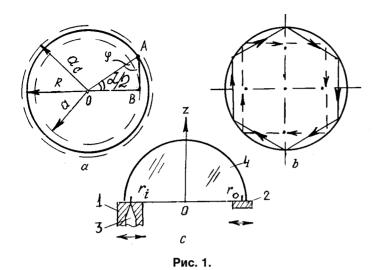
© С.Н. Харьковский, А.Е. Когут, В.В. Кутузов

Институт радиофизики и электроники НАН Украины, Харьков

Поступило в Редакцию 6 января 1997 г.

Обнаружено, что совместно с колебаниями типа шепчущей галереи в квазиоптических диэлектрических резонаторах возможно возбуждение лучевых колебаний. Показано, что при изменении условий возбуждения их поля постепенно "отщепляются" от полей колебаний шепчущей галереи, характеристики которых ухудшаются. Определен угловой спектр лучевых колебаний в диэлектрических резонаторах.

Явление высокодобротного резонанса волн типа шепчущей галереи в диэлектрических телах вращения используется в широком частотном диапазоне: от СВЧ до оптических [1,2]. В квазиоптических диэлектрических резонаторах с радиусом R, связанным с длиной волны λ_d в нем соотношением $R > 5\lambda_d$, их поле сосредоточено в узкой полосе у границы диэлектрика между каустиками с радиусами a и a_c (рис. 1,a) и может быть описано на основе волнового подхода. Вместе с этим из геометрооптических построений следует, что в таких резонаторах возможны колебания, траектория луча которых представляет правильный N-угольник, вписанный в окружность резонатора (рис. 1, b). В отличие от мод шепчущей галереи, которые являются результатом дифракции и интерференции волн источника у криволинейной границы, их описание может быть проведено в рамках геометрической оптики, поэтому мы называем их лучевыми колебаниями. При экспериментальном исследовании квазиоптических диэлектрических резонаторов в миллиметровом диапазоне длин волн нами замечено, что в них возможно одновременное возбуждение колебаний типа лучевых и шепчущих галерей. Особенно это заметно при использовании слабонаправленных источников излучения (открытый конец волновода, щель связи и др.). Для выяснения вопроса об их различимости и влиянии друг на друга проведены целенапра-



вленные исследования квазиоптического диэлектрического резонатора, одну половину которого заменяет зеркало со щелью связи. Отметим, что этот вопрос восходит к работам по распространению волн у изогнутой поверхности тела [3,4] и впервые поставлен нами в случае колебаний шепчущих галерей в квазиоптических диэлектрических резонаторах.

Приведем результаты исследования зеркального полушарового квазиоптического диэлектрического резонатора. Он содержит плоские отражатели I и 2 (рис. 1,c), в первый из которых устанавливается возбуждающий волновод 3, плавно сужающийся по узкой стенке до открытого конца — щели с размерами $7.2 \times 1 \, \mathrm{mm}^2$, на поверхности отражателя. Полушар 4 выполнен из фторопласта-4 радиусом $R=39 \, \mathrm{mm}$. Характеристики TM_{nml} ($E_r \neq 0$) колебаний шепчущих галерей исследуемого резонатора с n, m и l=1 вариациями поля по полярной, азимутальной и радиальной координатам соответственно описаны в [5]. На рис. 2, a представлены зависимости относительной амплитуды A/A_m резонанса и изменения его частоты Δf_{M} от нормированной радиальной координаты щели r_i/R (n=37, резонансная частота $f_n=36.6 \, \mathrm{GHz}$). Связь резонатора с подводящим волноводом была меньше критической вследствие дополнительных радиационных потерь из-за ограниченной

Письма в ЖТФ, 1997, том 23, № 15

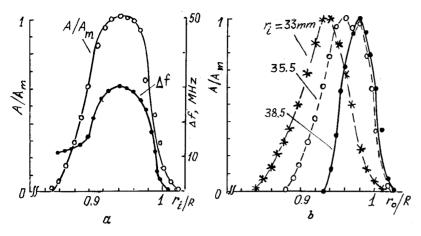


Рис. 2.

площади зеркал, но в каждой точке r_i подстраивалась до максимальной для данной системы путем изменения положения зеркала 2. Видно, что резонанс возбуждается непрерывно и эффективно в широком интервале изменения r_i , включающем и радиус внутренней каустики a колебаний шепчущих галерей (его расчет приведен ниже). При смещении щели изменяются амплитуда, форма и ширина резонанса. Для идентификации колебаний используем перемещение зеркала 2, протяженность которого вдоль радиальной координаты резонатора не превышает величину расстояния между каустиками волн шепчущих галерей. Зависимость относительной амплитуды резонанса A/A_m от нормированной радиальной координаты r_0/R середины зеркала 2 при фиксированных положениях щели показаны на рис. 2, δ . Замечаем, что при $r_i = 38.5\,\mathrm{mm}$ пятно поля укладывается по радиусу между каустиками шепчущих галерей. При уменьшении r_i пятно поля "расплывается" по радиусу в глубь диэлектрика. Например, при $r_i = 35.5\,\mathrm{mm}$ пятно поля расширяется на 50%. Это переходная область от колебаний шепчущих галерей к лучевым колебаниям. Дальнейшее уменьшение r_i приводит к тому, что при определенном положении щели ($r_i=33\,\mathrm{mm}$) формируется резонансное поле, пятно которого заметно "отщепляется" от пятна поля шепчущих галерей и в целом смещается в глубь диэлектрика.

Письма в ЖТФ, 1997, том 23, № 15

Исследование распределения поля по полярной координате показывает, что в чистом виде возбуждается лучевое колебание с N отражениями от вогнутой поверхности диэлектрика. В данном случа N=6 и при других N лучевое колебание не наблюдается.

Лучевые колебания образуют почти периодическую последовательность резонансов, частоты которых близки и в некоторых частях спектра практически совпадают с резонансными частотами колебаний шепчущих галерей. Их добротность на 30% меньше, чем добротность колебаний шепчущих галерей. Возбуждение переходных и (или) лучевых колебаний приводит к расширению и искажению резонансной кривой, "размыванию" пятна поля колебаний шепчущих галерей по радиусу, дополнительной модуляции их полярного распределения поля.

Определим угловой спектр и число отражений N луча от поверхности диэлектрика, при которых в чистом виде можно возбудить лучевые колебания в квазиоптических диэлектрических резонаторах с модами шепчущих галерей. Ограничимся на первом этапе двумерной моделью шепчущих галерей в круге. Из отраженных волн, дающих вклад в резонансное поле шепчущих галерей квазиоптических диэлектрических резонаторов выделим луч с наименьшим числом j отражений. Очевидно, что его траектория будет в виде правильного j-угольника, описанного около внутренней каустики моды шепчущих галерей. Радиус a внутренней каустики шепчущих галерей определяется выражением [6]:

$$a = nc/2\pi f_n \sqrt{\varepsilon},\tag{1}$$

где ε — диэлектрическая проницаемость материала резонатора, c — скорость света в вакууме.

Из геометрии задачи (см. Δ AOB, рис. 1, a, $\alpha/2=\pi/j$, $\varphi=\pi/2-\alpha/2$) и условия полного внутреннего отражения луча от границы диэлектрика определяем, что дискретный угловой спектр φ_N лучевых колебаний лежит в пределах

$$\arcsin(1\sqrt{\varepsilon}) < \varphi_N < \pi/2 - \arccos(nc/2\pi f_n \sqrt{\varepsilon}R).$$
 (2)

А число отражений N луча от круговой границы диэлектрика, соответствующее лучевым колебаниям, определяется из выражения

$$\pi / \left[\pi/2 - \arcsin(1/\sqrt{\varepsilon}) \right] < N < \pi/\arccos(nc/2\pi f_n \sqrt{\varepsilon}R).$$
 (3)

Письма в ЖТФ, 1997, том 23, № 15

Отметим, что в зеркальынх квазиоптических диэлектрических резонаторах резонансы образуют лучи, описывающие траектории в виде половин N-угольников c четными N.

В эксперименте $R=39\,\mathrm{mm},~\varepsilon=2.04.$ При $n=37,~f_n=36.6\,\mathrm{CHz}$ расчетный радиус каустики $a=37\,\mathrm{mm}$ или a/R=0.93, что совпадает с экспериментальной оценкой величины a. Из (3) получаем 4< N<8, что и наблюдалось (N=6).

Список литературы

- [1] Брагинский В.Б., Ильченко В.С., Городецкий М.Л. // УФН. 1990. Т. 160. В. 1. С. 157–163.
- [2] Диэлектрические резонаторы // М.Е. Ильченко, В.Ф. Взятышев, Л.Г. Гассанов и др. Под ред. М.Е. Ильченко. М.: Радио и связь, 1989. 328 с.
- [3] Кинбер Б.Е. // Радиотехника и электроника. 1961. Т. 6. № 8. С. 1273–1283.
- [4] Бабич В.М., Булдырев В.С. Асимптотические методы в задачах дифракции коротких волн. М.: Наука, 1972. 456 с.
- [5] Харьковский С.Н., Когут А.Е., Солодовник В.А. // Письма в ЖТФ. 1995.Т. 21. В. 18. С. 38–42.
- [6] Власов С.Н. // Радиотехника и электроника. 1967. Т. 12. № 3. С. 572–573.